最 高 行 政 法 院 判 決

109年度判字第29號

上　訴　人　樂福太陽能股份有限公司
代　表　人　錢正治
訴訟代理人　呂紹凡　律師
　　謝祥揚　律師
被上訴人　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
參　加　人　新能光電科技股份有限公司
代　表　人　張錦龍

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國107年7月19日智慧財產法院106年度行專訴字第55號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決駁回上訴人於原審之訴關於「請求項2、3、5至14、請求項18、20、21」暨該訴訟費用部分均廢棄，發回智慧財產法院。

其餘上訴（即系爭專利請求項16、17、19、22至29項部分及該訴訟費用部分）駁回。

駁回部分上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

壹、本件參加人之代表人已由昇陽光電科技股份有限公司變更為張錦龍，茲經其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

貳、緣上訴人之前手劍揚股份有限公司前於民國98年7月30日以「具有色彩調變之太陽能電池及其製造方法」向被上訴人申請發明專利，並以97年8月14日及98年5月19日向美國申請之第61/088,779及12/468,606號專利案主張優先權，經被上訴人編為第00000000號審查，期間該專利之申請權讓與上訴人，嗣經被上訴人於102年7月22日准予專利（申請專利範圍計30項），發給發明第I409962號專利證書（下稱系爭專利，專利圖式如附圖一所示）。上訴人另於103年8月6日提出該專利說明書及申請專利範圍更正本（更正後申請專利範圍共28項，即請求項1至14及16至29，請求項15及30已刪除），

經被上訴人准予更正並公告。嗣參加人以該專利請求項1至14、16至29違反核准時專利法第22條第1項第1款、第2項、第26條第1項、第2項及第67條第4項之規定，對之提起舉發。上訴人則另於104年7月24日及105年2月3日提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經被上訴人審查，以105年11月24日（105）智專三（二）01159字第10521447700號專利舉發審定書為「105年2月3日之更正事項，准予更正」、「請求項2至3、5至14、16至29舉發成立，應予撤銷」、「請求項1、4舉發駁回」之處分。上訴人不服前揭處分中關於「請求項2至3、5至14、16至29舉發成立，應予撤銷」之部分，提起訴願，經經濟部以106年6月3日經訴字第10606305070號決定駁回，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分關於「請求項2至3、5至14、16至29舉發成立，應予撤銷」之部分。原審因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分關於舉發成立部分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加被上訴人之訴訟。經原審判決駁回上訴人於原審之訴，上訴人仍不服，提起本件上訴。

參、上訴人起訴主張及被上訴人在原審答辯及聲明，均引用原判決所載。

肆、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：㈠證據7足以證明系爭專利請求項16至17、19、22不具新穎性：㈠系爭專利請求項16與證據7相較，證據7圖3(A)至3(C)揭露光伏打裝置中之光伏打層33（與證據7圖式所稱「光電伏打層」有異，以下同）相當於系爭專利之光電轉換層，而其ITO透明導電膜34及輔助電極35之整體與電極32則相當於系爭專利之第一電極及第二電極。又證據7及圖3(C)揭露色彩層、漫射層37設置於光伏打層33上方，用以調變其色彩外觀，且覆蓋ITO透明導電膜34及輔助電極35之整體，而證據7之熱感接合劑層36（與證據7圖式所稱「熱感結合劑」有異，以下同）並非必要元件，當未使用熱感接合劑層36時，漫射層37即與透明導

電膜34及輔助電極35直接接觸，即相當於系爭專利之「色彩調變層直接接觸第一電極」技術特徵；雖證據7形式上未揭露系爭專利之色彩調變層包括至少一介電材料，惟每一物質均具有一定的介電係數，故可視為一介電材料。準此，系爭專利請求項16之全部技術特徵已為證據7所揭露，是證據7足以證明系爭專利請求項16不具新穎性。㈡系爭專利請求項17、19、22係依附於請求項16，而系爭專利請求項17、19、22之全部技術特徵已為證據7所揭露，是證據7足以證明系爭專利請求項17、19、22不具新穎性。㈢證據7圖3(A)至3(C)已揭露「色彩層(聚對苯二甲酸乙二酯膜39及未固化樹脂組合物40)」係設置於光伏打層33之上方，以調變光伏打電池之色彩外觀之用，其覆蓋ITO透明導電膜34及輔助電極35之整體，此外，設置於光伏打層33上方之漫射層37除可用於散射及分散光線外，亦可調變色彩，且其覆蓋ITO透明導電膜34及輔助電極35之整體，故色彩調變層可包含聚對苯二甲酸乙二酯膜39、未固化樹脂組合物40及漫射層37，且證據7之熱感接合劑層36並非必要元件，而當未使用熱感接合劑層36時，漫射層37即與透明導電膜34及輔助電極35直接接觸，故證據7已揭露系爭專利之「色彩調變層直接接觸第一電極」技術特徵。㈣證據7足以證明系爭專利請求項16至17、19、22至29不具進步性：㈠系爭專利請求項16至17、19、22為所屬技術領域中具有通常知識者依證據7之內容所能輕易完成，是證據7足以證明系爭專利請求項16至17、19、22不具進步性。又系爭專利請求項23、24係依附於請求項16，請求項23要求之光電轉換層具有非粗糙表面為使半導體材料表面平坦化之處理方法、於太陽能電池上設置保護層及透明層，保護太陽能電池，均為該發明所屬技術領域之通常知識，是由證據7並參酌通常知識足以證明系爭專利請求項23、24不具進步性。另系爭專利請求項25至28係依附於請求項24，保護層及透明層之材質與折射率，亦為該發明所屬技術領域中之通常知識，是由證據7並參酌通常知識足以證明系爭專利請求

項25至28不具進步性。㈡系爭專利請求項29為一種太陽能電池的製造方法，證據7圖3(A)至3(C)揭露光伏打裝置中之光伏打層33相當於系爭專利之光電轉換層，且揭露ITO透明導電膜34及輔助電極35之整體與電極32即相當於系爭專利之第一電極及第二電極；又證據7及圖3(C)揭露色彩層、漫射層37設置於光伏打層33上方，用以調變其色彩外觀，且雖證據7形式上未揭露系爭專利之色彩調變層包括至少一介電材料，惟每一物質均具有一定的介電係數，故可視為一介電材料。綜上比較，系爭專利請求項29之第一電極和第二電極係設置於上述光電轉換層之同一側表面上，固與證據7有所差異，惟證據11及圖7.14已揭露第一電極和第二電極可設置於光電轉換層之同一側表面上，且該證據為歸納習知太陽能電池基礎知識之教科書，其揭露之內容當然屬於系爭專利申請時所屬技術領域中具有通常知識者所具有之一般知識，是系爭專利請求項29為所屬技術領域中具有通常知識者依其所具有之一般知識，簡單修飾證據7之內容所能輕易完成。從而，證據7足以證明系爭專利請求項29不具進步性。㈢由系爭專利揭露之色彩調變之太陽能電池及其製造方法發明，可知系爭專利係為利用半導體材料技術領域之發明，且由證據6第【0027】段揭露之內容，可知太陽能電池9之受光側具有透光性密封劑10(相當於系爭專利之保護層)可為EVA、透光性構件(相當於系爭專利之保護層)可為玻璃，以及EVA與玻璃具有約1.5之折射率為「習知」之資訊，據此，自可佐證原處分之認定應無違誤。從而，具有前述通常知識及執行例行工作、實驗之普通能力，能理解、利用系爭專利申請日之前之先前技術者，即為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者。㈢證據6、11之組合足以證明系爭專利請求項2至3、5至14、16至29不具進步性：㈠系爭專利請求項2：1.系爭專利請求項2與證據6、11相較，證據6揭露之基板1、n型擴散層2及p型層7之整體即相當於系爭專利之光電轉換層；受光面電極5及背面電極8亦相當於系爭專利之第一電極及第二電極；第

一抗反射膜及/或第二抗反射膜則相當於系爭專利之色彩調變層。而第一抗反射膜可使用TiOx、SiNx以及第二抗反射膜可使用Al2O3、SiNx、ITO膜等則相當於系爭專利之色彩調變層包含氧化物、氟化物、硫化物、氮化物、碲化物及硒化物等介電材料中之至少一者所構成。綜上比較，雖證據6未揭露系爭專利之色彩調變層覆蓋上述至少一第一電極，然證據11第10.10圖已揭露該抗反射覆層（相當於系爭專利之色彩調變層）覆蓋該前電極，且證據11第7.7圖亦揭露該前電極貫穿該抗反射覆層，即表示在系爭專利申請日前已有「該抗反射覆層覆蓋該前電極」以及「該前電極貫穿該抗反射覆層」等兩種技術；而證據6以及證據11均同屬太陽能電池之技術領域，且均為系爭專利之先前技術，其等揭露之內容仍當然屬於系爭專利申請時所屬技術領域中具有通常知識者所具有之一般知識而可整體組合運用，且其組合並無扞格且能輕易完成，當系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者面臨如何提高製程效率、產品良率及其外觀色彩之相關問題時，應有其動機結合證據6以及證據11之技術內容並予以應用或組合。準此，證據6、11之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。2.系爭專利之實驗例Ⅳ之色彩調變層26折射率/厚度限制、總厚度限制均大於前述證據6之限制，但其反射率亦較證據6圖5所揭示之反射率高出甚多，而過高的反射率會降低太陽能電池的轉換效率，是以系爭專利之實驗例Ⅳ的太陽能電池的轉換效率可能遠低證據6圖5之發明，上訴人僅以系爭專利克服了前述證據6之折射率/厚度限制、總厚度限制，而未細查系爭專利之色彩調變層26因光學膜厚的增加而導致其轉換效率可能遠低於證據6圖5之發明，自難謂系爭專利之實驗例Ⅳ在功效上較證據6圖5之發明有何改良增進。㈡系爭專利請求項3係依附於請求項2，既證據6、11之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性，又證據6及圖1、5b揭露受光面電極5經由第一抗反射膜3之開口與基板1、n型擴散層2及p型層7整體接觸，且第二抗反射膜4之厚度可大於第一抗

反射膜3之厚度，證據11揭露包含複數層薄膜之抗反射層僅為通常知識，是證據6、11之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。㈢系爭專利請求項5為一種太陽能電池，證據6揭露第一抗反射膜可使用TiOx、SiNx以及第二抗反射膜可使用Al2O3、SiNx、ITO膜等（相當於系爭專利之色彩調變層包含氧化物、氟化物、硫化物、氮化物、碲化物及硒化物等介電材料中之至少一者所構成）；證據6圖1並揭露第一抗反射膜及第二抗反射膜直接接觸受光面電極。準此，證據6、11之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性。㈣系爭專利請求項6至9、10至13：1.系爭專利請求項6、7、8、9為一種太陽能電池，系爭專利請求項6至9與證據6、11相較，系爭專利請求項6至9所具有共同之技術特徵，已為證據6、11所揭露。又系爭專利請求項6之「上述色彩調變層具有1至5,000nm之均勻厚度」，可見於證據6第【0028】、【0029】段及圖5所揭露之第一抗反射膜3之厚度可為80nm，第二抗反射膜之厚度為30nm、36nm……等；系爭專利請求項7之「上述光電轉換層具有粗糙表面」，於證據6第【0021】段揭露n型擴散層2（相當於光電轉換層之最上面）上以CVD積層，可知n型擴散層2具有粗糙表面為證據6所隱含之技術特徵；系爭專利請求項8之「上述光電轉換層具有非粗糙表面」，為使半導體材料表面平坦化之處理方法，為該發明所屬技術領域之通常知識；系爭專利請求項9之「尚包括一保護層和一透明層，依序設置於上述色彩調變層上方，且上述色彩調變層包含一層或複數薄膜」，於證據6第【0027】段揭露太陽能電池可包含透光性密封劑及透光性構件，依序覆蓋太陽能電池。準此，證據6、11之組合足以證明系爭專利請求項6至9不具進步性。2.系爭專利請求項10至13係直接或間接依附於請求項9，證據6第【0027】段揭露透光性密封劑10可為EVA、透光性構件可為玻璃，以及EVA與玻璃具有約1.5之折射率等技術特徵，是證據6、11之組合足以證明系爭專利請求項10至13不具進步性。㈤系爭專利請求項14為一種太陽能電池，

證據6已揭露系爭專利之光電轉換層、第一電極、第二電極及色彩調變層。雖證據6未揭露系爭專利「上述第一電極和上述第二電極係設置於上述光電轉換層之同一側表面上」，惟證據11及圖7.14已揭露第一電極和第二電極可設置於光電轉換層之同一側表面上。準此，證據6、11之組合足以證明系爭專利請求項14不具進步性。㈥系爭專利請求項16至28：系爭專利請求項16為一種太陽能電池的製造方法，雖證據6未揭露系爭專利請求項16之色彩調變層覆蓋上述至少一第一電極，然證據11圖10.10已揭露該抗反射覆層（相當於系爭專利之色彩調變層）覆蓋該前電極。準此，證據6、11之組合足以證明系爭專利請求項16不具進步性。又系爭專利請求項17、19至24係依附於請求項16、請求項18係依附於請求項17，而系爭專利請求項17之抗反射膜、位置及厚度條件均已具體揭露於證據6、利用穿透效應使太陽能電池之電極透過絕緣層與半導體層相連之技術為該領域之通常知識、請求項19要求之色彩調變層材質已具體揭露於證據6第【0025】段、請求項20要求之色彩調變層厚度已具體揭露於證據6第【0028】、【0029】段及圖5、證據6第【0014】段已揭露第一、二抗反射膜係以CVD所形成、請求項22要求之光電轉換層具有粗糙表面已於證據6第【0021】段所隱含、請求項23要求之光電轉換層具有非粗糙表面，為使半導體材料表面平坦化之處理方法，為該發明所屬技術領域之通常知識、請求項24要求之保護層、透明層已具體揭露於證據6第【0027】段，是證據6、11之組合足以證明系爭專利請求項17至24不具進步性。另系爭專利請求項25至28係依附於請求項24，請求項25至28要求之保護層、透明層之材質與折射率已具體揭露於證據6第【0027】段，是證據6、11之組合足以證明系爭專利請求項25至28不具進步性。㈦系爭專利請求項29為一種太陽能電池的製造方法，雖系爭專利界定其第一電極和第二電極係設置於光電轉換層之同一側表面上，惟證據11及圖7.14已揭露第一電極和第二電極可設置於光電轉換層之同一側表

面上，是證據6、11之組合足以證明系爭專利請求項29不具進步性。四、依核准時專利法第26條第1項、第2項、第3項規定，上訴人雖主張其歷經多次研發改造、解決多項難題後始成功發明系爭專利，惟觀諸其發明專利說明書、申請專利範圍及摘要，就此部分之歷程均未見著墨，難認已符合揭露要件，而其申請專利範圍與上述各證據組合比對結果，無從證明上開各請求項具新穎性、進步性。準此，原處分之審定，及訴願機關之決定，均無違誤等語，為其判斷之基礎。

伍、上訴意旨略以：

一、證據11僅揭露習知「藍黑色」太陽能電池結構，並未揭露「色彩調變」之技術手段。原判決遽認證據11第10.10圖已揭露「抗反射覆層」，並以該「抗反射覆層」相當於系爭專利之色彩調變層。證據11第7.7圖所揭示之技術特徵，似呈現該「前電極」「完全未覆蓋」該「抗反射覆層」之態樣。原判決卻認定「證據11第7.7圖亦揭露該前電極貫穿該抗反射覆層」。原判決未先確認系爭專利請求項2所載發明之內容，即率將證據6、11之組合與系爭專利請求項2予以比對，遽認系爭專利請求項2不具進步性，顯有調查職責未盡之違法，並有認定事實未憑證據、判決理由不備之違法。

二、原判決先認證據6為「通常知識」，嗣又認其為「一般知識由此可見，原判決關於證據6是否屬「通常知識」之認定，與其對於「通常知識」之界定，顯然前後矛盾。又原判決既已認定證據6、證據11在技術水平上確有差異，在未辨明系爭專利所屬技術領域中具通常知識者之技術水準之前，逕認有動機結合證據6及證據11之技術內容並予以應用或組合，顯有認定事實未憑證據、判決理由不備暨理由矛盾之判決違背法令。

三、依系爭專利說明書可知，「光學膜厚」、「轉換效率」等技術內容皆未記載於系爭專利說明書，且該等技術內容亦非當事人間之攻擊防禦方法之技術內容，則原判決就系爭專利實驗例IV、證據6圖5之上開技術特徵之解釋及理解，自係原審

自行分析比對之結果，其內容確屬法院已知之特殊專業知識。惟原審未將本於其所知之特殊專業知識予當事人有辯論之機會，遽採為裁判之基礎，顯然違反智慧財產案件審理法第34條準用第8條規定，確屬判決違背法令。

四、關於系爭專利有無針對相關技術之改良並解決彼時現實困難等情，系爭專利說明書確已詳實記載。原判決漏未斟酌系爭專利關於先前技術之記載，更未向當事人闡明應提出系爭專利克服先前技術之客觀證據，即遽為不利上訴人之論斷，確有違反行政訴訟法第125條第2項、第3項規定之違背法令等語。

陸、本院查：

一、按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為專利法第71條第3項本文所明定，其立法理由謂：「核准發明專利權之要件係依核准審定時之規定辦理，其有無得提起舉發之情事，自應依審定時之規定辦理，始為一致，爰予明定。」查系爭專利申請日為98年7月30日，經被上訴人准予發明專利，於102年7月22日審定核准，並於102年9月21日公告。參加人於104年4月14日提出舉發，上訴人則於104年7月24日及105年2月3日提出申請專利範圍更正本，案經被上訴人於105年11月24日作成「105年2月3日之更正事項，准予更正。請求項2至3、5至14、16至29舉發成立，應予撤銷。請求項1、4舉發駁回」之處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之102年6月11日修正公布、102年6月13日施行之專利法（即核准時專利法）規定為斷。

二、次按，利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用之發明，得依核准時專利法第21條、第22條規定申請取得發明專利。又發明於申請前已見於刊物，或為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得取得發明專利，同法第22條第1項第1款、第2項定有明文。

三、上訴駁回（即系爭專利請求項16至17、19、22至29項）部分

：

原判決關於證據7足以證明系爭專利請求項16至17、19、22不具新穎性，另證據7既足以證明系爭專利請求項16至17、19、22不具新穎性，則系爭專利請求項16至17、19、22為所屬技術領域中具有通常知識者依證據7之內容所能輕易完成，當然證據7足以證明系爭專利請求項16至17、19、22不具進步性；另證據7亦足以證明系爭專利請求項23至29不具進步性之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；此部分上訴聲明雖予列入求予廢棄，但上訴意旨並未提出指摘原判決違背法令之理由，是此部分之上訴為無理由，應予駁回。

四、原判決應予廢棄（即證據6、11之組合足以證明系爭專利請求項2至3、5至14、請求項18、20、21）部分：

㈠首先，因證據7足以證明系爭專利請求項16至17、19、22不具新穎性，亦足以證明系爭專利請求項23至29不具進步性，所以應予廢棄部分係關於證據6、11之組合者，自不應再重覆包含上開請求項，則證據6、11之組合關於系爭專利請求項16至29部分中，只要論述請求項18、20、21部分即可，請求項16、17、19、22原判決雖予贅述，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當，先此敘明。

㈡按關於舉發案件進步性之判斷，應先確定先前技術（即舉發證據）之範圍及內容，繼之確定系爭發明與舉發證據間之差異，最後以該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌舉發證據所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成系爭發明。如系爭發明與舉發證據間所存在之差異，為系爭發明之重要技術特徵者，審查時應就該技術特徵是否為舉發證據所揭露，或該技術特徵是否為該發明所屬技術領域中具通常知識者，以轉用、置換、改變或組合舉發證據等方式所能輕易完成等情，詳加審酌。進步性之審查不得以發明

說明中循序漸進、由淺入深的內容所產生的『後見之明』作成能輕易完成的判斷，逕予認定發明不具進步性；而應將系爭發明的整體與舉發證據進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之觀點，作成客觀的判斷。

1. 上訴人於105年2月3日申請專利範圍更正本係更正刪除103年12月1日所公告申請專利範圍之請求項1、4，並更正請求項2、5至9、14、16、17至28之內容，經被上訴人審查核准並於105年12月21日公告，嗣當事人均未對該更正表示不服，是本件應依更正後之申請專利範圍審查。

2. 其中更正後系爭專利請求項2（及其他相同記載之獨立項、附屬項3、5至14、16至29，以下簡稱請求項2等）記載：「一種太陽能電池，包括：一光電轉換層，用以從一入射光產生電能；至少一第一電極和至少一第二電極，分別設置於上述光電轉換層之相對表面上方，用以輸出上述電能；一色彩調變層，設置於上述光電轉換層上方，用以調變其色彩外觀，但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極，其中該色彩調變層係由氧化物、氟化物、硫化物、氮化物、碲化物及硒化物之中至少一介電材料所構成，尚包括一抗反射層，設置於上述色彩調變層和上述光電轉換層之間。」上述請求項2等所稱：一色彩調變層……「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」，係更正前請求項2內容：一色彩調變層……「且上述色彩調變層覆蓋上述至少一第一電極」，其中所謂「不包括……完全未覆蓋」之用語應如何解釋，則未見原判決有所說明。以致請求項2等所稱：「一色彩調變層……但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」之技術特徵，仍陷於不明。

3. 依原判決書所載：「綜上比較，雖證據6未揭露系爭專利之色彩調變層覆蓋上述至少一第一電極」等語（原判決書第32頁），似認為請求項2等所稱「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」，係等同於「色彩調變層覆

蓋上述至少一第一電極」之意。然而，請求項2等所稱「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」，依審定書准予更正審定所載理由係：「經查本局103年12月1日所核准之更正內容（公告於103年12月21日）為『……色彩調變層覆蓋上述至少一第一電極』，其實施態樣包括『色彩調變層完全覆蓋所有的第一電極』、『色彩調變層部分覆蓋所有的第一電極』……等等多種覆蓋可能之態樣，依本案說明書第7-8頁所揭示實施例I-IV所揭示內容及圖5可知，更正後排除了『色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極』以更明確表達色彩調變層與第一電極之覆蓋關係，該更正符合不明瞭記載之釋明，並且進一步限定色彩調變層之成份材質係由氧化物、氟化物、硫化物、氮化物、碲化物及硒化物之中至少一介電材料所構成，符合申請專利範圍之減縮，該更正未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合現行專利法第67條第1項第2、4款及第2、4項之規定，准予更正。」顯然更正後排除了「色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」以更明確表達色彩調變層與第一電極之覆蓋關係，該更正符合不明瞭記載之釋明。上開更正，色彩調變層之成份材質固有減縮申請專利範圍，但「且上述色彩調變層覆蓋上述至少一第一電極」更正為「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」部分，原申請專利範圍之「色彩調變層覆蓋上述至少一第一電極」於更正後，依通常知識之人之理解，是否尚有減縮申請專利範圍。該部分之更正若有減縮，則其申請專利範圍已較更正前減小，原判決仍依更正前之申請專利範圍，解釋更正後請求項2等「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」，自屬有誤。

4.綜上，原判決在未先究明請求項2等之「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」部分意義之前，即遽將請求項所載特徵與前案技術予以比對，顯有判決理由不

備之違法。

㈢此外，證據11為Jenny Nelson於西元2003年所著教科書「The Physics of Solar Cells」之節本，其公開日早於系爭專利最早優先權日，可為系爭專利相關之先前技術，其技術內容提供太陽能電池易於理解的介紹，兩終端串接型磷化銦鎵/砷化鎵太陽能電池之層結構(即串接電池)具有磷化銦鎵、砷化鎵穿隧接面、磷化鋁鎵窗戶層、砷化鎵、前電極、金屬層以及抗反射覆層，磷化銦鎵、砷化鎵穿隧接面、磷化鋁鎵窗戶層、砷化鎵的一面設有前電極，另外一面設有金屬層上，該抗反射覆層則設置於該磷化銦鎵、該砷化鎵穿隧接面、該磷化鋁鎵窗戶層、該砷化鎵上（其圖式證據11第10.10圖及第7.7圖，如附圖四所示）。此為兩造所不爭，堪認為實。證據11之技術內容係提供太陽能電池易於理解的介紹，原判決依循審定書，訴願決定書一路說詞，僅謂「證據11第10.10圖已揭露該抗反射覆層（相當於系爭專利之色彩調變層）覆蓋該前電極，且證據11第7.7圖亦揭露該前電極貫穿該抗反射覆層，即表示在系爭專利申請日前已有「該抗反射覆層覆蓋該前電極」以及「該前電極貫穿該抗反射覆層」等兩種技術，究竟所屬技術領域中具有通常知識者如何依附圖四所示之兩圖，理解及認定證據11，原判決並未加以詳認，亦有判決不備理由之違法。

五、綜上所述，原判決關於應予廢棄部分既有如上所述之違法，並影響判決結論，故上訴意旨指摘原判決違法，求予廢棄，即有理由。又因本件事實尚有由原審再為調查之必要，本院尚無從自為判決，爰將原判決此部分廢棄，發回原審再為調查後，另為適法之裁判。

柒、據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第256條第1項、第260條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　1　　月　　21　　日

最高行政法院第四庭

審判長法官　鄭　小　康

法官　林　文　舟

法官　帥　嘉　寶

法官　林　玫　君

法官　劉　介　中

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　華　民　國　109　年　1　月　21　日

書記官　劉　柏　君